

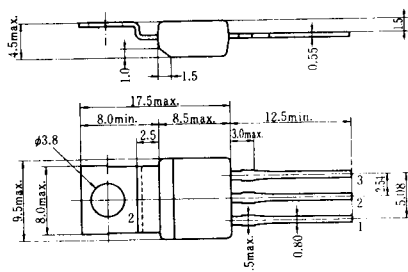
# 2SD757, 2SD758

シリコン NPN エピタキシャル形

低周波高電圧増幅用  
2SB717, 2SB718とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER  
Complementary pair with 2SB717 and 2SB718



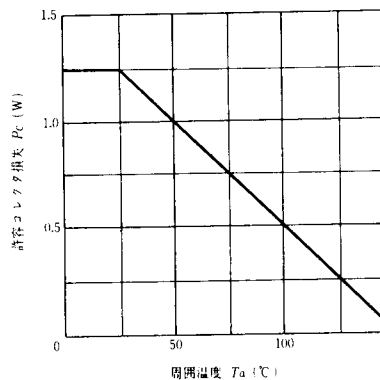
(JEDEC TO-202AA MOD.)

1. ベース: Base
  2. コレクタ: Collector
  3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SD757	2SD758	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	160	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	160	200	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	5	V
コレクタ電流	$I_C$	50	50	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	100	100	mA
許容コレクタ損失	$P_C$	1.25	1.25	W
接合部温度	$T_j$	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{\text{sig}}$	-45~+150	-45~+150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	2SD757			2SD758			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	160	—	—	200	—	—	
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	160	—	—	200	—	—	
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	5	—	—	
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=140\text{V}, I_E=0$	—	—	10	—	—	—	
		$V_{CB}=160\text{V}, I_E=0$	—	—	—	—	—	10	
直流電流増幅率	$h_{FE1}$ *	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	60	—	320	60	—	320	
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	30	—	—	30	—	—	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	—	1.5	—	—	1.5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}$	—	—	2	—	—	2	
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	140	—	—	140	—	M
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	3.8	—	—	3.8	—	

\*2SD757, 2SD758は $h_{FE1}$ の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

\*The 2SD757 and 2SD758 are grouped by  $h_{FE1}$  as follows.

B	C	D
60~120	100~200	160~320